

# 凝聚态物理-北京大学论坛

2016年第11期 (No. 374 since 2001)

## 非易失存储器

龙世兵 研究员

时间: 5月12日 (星期四) 15:00—16:30

地点: 北京大学物理大楼中212教室

**摘要:** 半导体存储器是集成电路最重要的技术之一, 有着巨大的市场。主流的硅基浮栅存储器逐渐面临理论和技术限制, 基于新材料、新结构、新原理和新集成架构的新型存储技术成为高密度存储发展的趋势。本报告将介绍电荷俘获存储器 (CTM) 和阻变存储器 (RRAM) 这两种新型存储器实现应用所需解决的基本科学问题, 以及中科院微电子所在材料、机理、可靠性、集成等方面的研究进展和成果。

**报告人简介:** 龙世兵, 中国科学院微电子研究所研究员, 中国科学院大学岗位教授, 优秀青年科学基金项目获得者, IEEE会员, 中国电子学会高级会员。从事纳米加工和新型非挥发性存储器的研究。发表SCI论文100余篇, SCI他引1500余次, 合作撰写著作2本, 获得/申请专利100余项。获得2010年北京市科学技术奖一等奖、2013年国家技术发明奖二等奖、2014年北京市科学技术奖二等奖、2015年中国电子学会科学技术奖自然科学类一等奖。

联系人: 廖志敏副教授

Host professor: [liaozm@pku.edu.cn](mailto:liaozm@pku.edu.cn)

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

<http://www.phy.pku.edu.cn/~icmp/forun/2016/2016qiu.xml>